

关键指标

频率: 6~16GHz
增益: 23.5dB
噪声系数: 1dB
1dB 压缩点输出功率: 17dBm
电压/电流: +5V/65mA
芯片尺寸: 1.8mm×0.9 mm

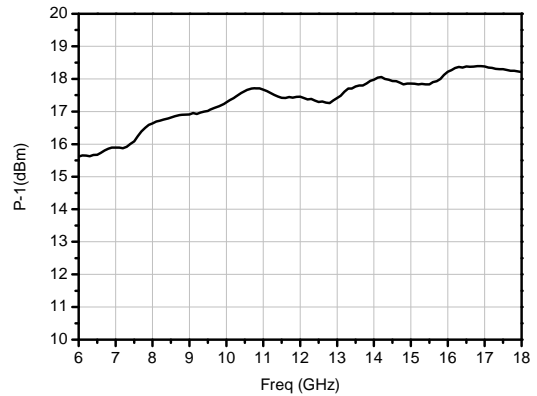
产品简介

HG116F-8是一款6~16GHz 宽带低噪声放大器芯片, 单电源供电, 输入输出端均已集成隔直电容。广泛应用于无线通信。

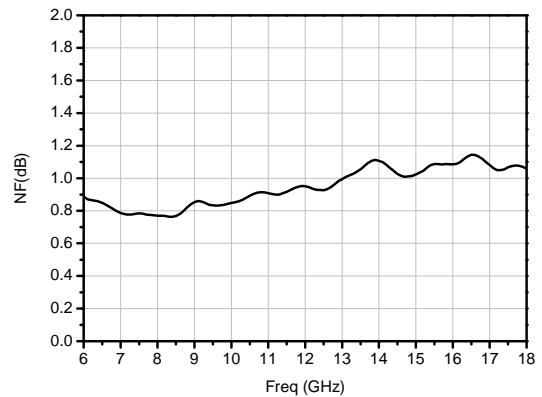
电性能 (T_A=25°C, V_{dd} =+5V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	6~16		
增益(dB)	-	23.5	-
增益平坦度(dB)	-	±0.5	-
输入回波损耗(dB)	-	-12	-
输出回波损耗(dB)	-	-15	-
噪声系数(dB)	-	1	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	17	-
静态电流 (mA)	-	65	-

1dB 压缩点输出功率

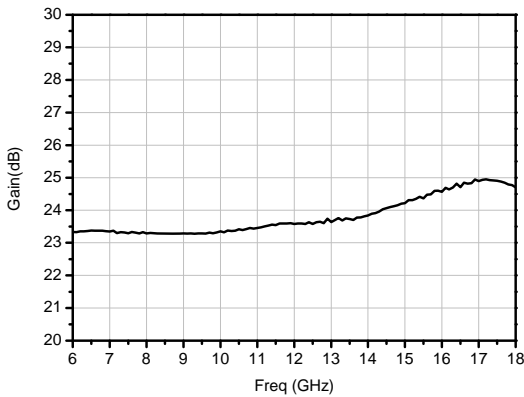


噪声系数

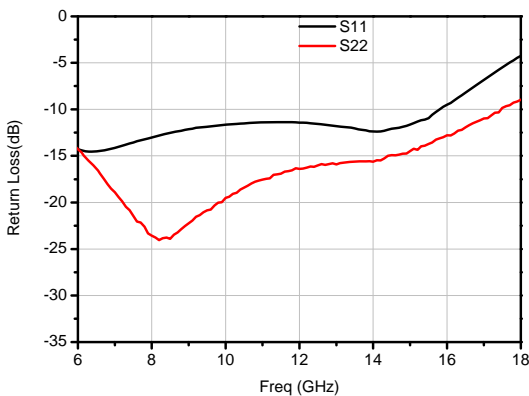


典型测试曲线

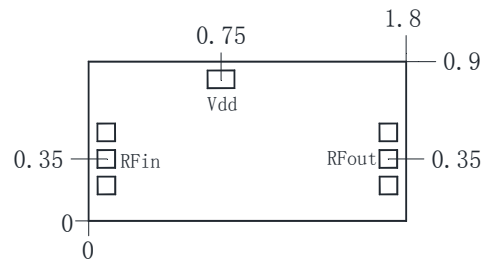
增益



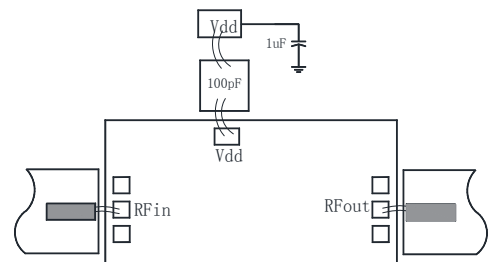
回波损耗



外形和端口尺寸(mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。